

单晶N型硅片(M10)

182.2x182.2



几何参数

边宽 182.2±0.25mm

对角线 247mm, 公差±0.25mm

厚度 130(+10/-8)μm

弧长投影 7.72±0.5mm

电学性能

电阻率 0.6-1.6Ω·cm

少子寿命 ≥1000μs

氧含量 ≤5.75x10¹⁷at/cm³

碳含量 ≤5x10¹⁶at/cm³

材料性能

生长方法 CZ(拉直)法

晶向 <100>±2°

表面性能

TTV ≤20

翘曲度 ≤40

线痕 ≤13

边缘崩边 深度≤0.3mm,长度≤0.5mm,不多于一处

裂纹和穿孔 目测不可见

硅片表面 干净, 无油污、肥皂和胶水等残留物